

Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250BW - SSD - encrypted - 250 GB - internal - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - buffer: 512 MB - 256-bit AES - TCG Opal Encryption



På lager(6)

SKU	MZ-V7S250BW
Produktbeskrivelse:	Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250BW - SSD - 250 GB - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Type:	Solid state-drev - intern
Kapacitet:	250 GB
Hardware kryptering:	Ja
Krypterings algoritme:	256-bit AES
NAND Flashhukommelses- type:	Tredobbelt-niveau celle (TLC)
Model:	M.2 2280



Generelt

Enhedstype: Solid state-drev - intern

Kapacitet: 250 GB

Hardware
kryptering: Ja

Krypterings
algoritme: 256-bit AES

NAND
Flashhukommelses-
type: Tredobbelt-niveau celle (TLC)

Model: M.2 2280

Grænseflade: PCIe 3.0 x4 (NVMe)

Buffer størrelse: 512 MB

Egenskaber: TRIM support, Auto Garbage
Collection Algorithm, Dynamic
Thermal Guard protection,
TurboWrite Technology, V-NAND
Technology, NVM Express
(NVMe) 1.3, Samsung Phoenix
Controller, S.M.A.R.T.

Bredde: 22.15 mm

Dybde: 80.15 mm

Højde: 2.38 mm

Vægt: 8 g

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 70 °C

Modstandsdygtighed over for
stød (operativ): 1500 g @ 0,5 ms
halv-sinus

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 5 år

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 1667

Effekt

Strømforbrug: 5 Watt (gennemsnitlig) ; 8 Watt
(maksimum) ; 30 mW (ledigt maks.)

Ekspansion og forbindelse

Interface: PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card

Kompatibel bås: M.2 2280

Driftssikkerhed

MTBF (forventet tid mellem fejl): 1,500,000 timer

Præstation

SSD-udholdenhed: 150 TB

Intern datahastighed: 3500 MBps (læs) / 2300
MBps (skriv)

4KB Random Read: 17000 IOPS

4KB Random Write: 60000 IOPS

Maximum 4KB Random
Write: 550000 IOPS

Maksimal 4 KB tilfældig
læsning: 250000 IOPS